

## ★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 国清辰也 副委員長 品田高宏

幹事 黒田理人・山口 直 幹事補佐 池田浩也

日時 6月20日(火) 13:00~17:10

会場 キャンパス・イノベーションセンター東京(港区芝浦3-3-6. <http://www.cictokyo.jp/access.html>)

議題 MOSデバイス・メモリ高性能化—材料・プロセス技術

1. [依頼講演] シンチレータとGa<sub>2</sub>O<sub>3</sub>半導体

○岡田 豪・白井雄輝・河野直樹・河口範明・柳田健之(奈良先端大)

2. [依頼講演] SOI技術を用いた量子イメージング検出器の開発—半導体で素粒子・X線を見る—  
新井康夫(高エネ研)

3. [依頼講演] ウェアラブル皮膚アセトン測定に向けたWO<sub>3</sub>ナノ粒子半導体ガスセンサの研究  
山田祐樹・檜山 聡(NTTドコモ)・○田畑 仁(東大)

4. [依頼講演] ダイヤモンド中の窒素-空孔センターによる高感度センシング技術  
○岩崎孝之・波多野睦子(東工大)

5. XPSによるHigh-k/SiO<sub>2</sub>界面の化学構造及びダイポールの評価

○藤村信幸・大田晃生・池田弥央・牧原克典・宮崎誠一(名大)

6. 定電圧及び定電流印加によるSi酸化薄膜の電気抵抗変化特性評価

○大田晃生・加藤祐介・池田弥央・牧原克典・宮崎誠一(名大)

7. 分極接合基板上pチャネルGa<sub>2</sub>N MOS構造のインピーダンス解析

○高山留美・星井拓也(東工大)・中島 昭(産総研)・西澤伸一(九大)・大橋弘通・角嶋邦之・若林 整・筒井一生(東工大)

8. 高濃度SOI基板と転写法によるTMDC FETsの作製

○川那子高暢・居駒 遼・高木寛之・小田俊理(東工大)

9. 硫黄雰囲気硫化プロセスによるスパッタMoS<sub>2</sub>薄膜の低キャリア密度化

○松浦賢太郎・大橋 匠・宗田伊理也(東工大)・石原聖也(明大)・角嶋邦之・筒井一生(東工大)・小椋厚志(明大)・若林 整(東工大)

10. Ge<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>ゲートスタック構造における欠陥の物性評価

○金田裕一・池 進一・兼松正行・坂下満男・竹内和歌奈・中塚 理・財満鎮明(名大)

11. エピタキシャルAg(111)上の極薄IV族結晶形成

○伊藤公一・大田晃生・黒澤昌志・洗平昌晃・池田弥央・牧原克典・宮崎誠一(名大)

◆応用物理学会;シリコンテクノロジー分科会共催

### 【問合先】

黒田理人(東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail: rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp